

## INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES, DE TECHNOLOGIE ET DE COMMERCE

ACCORD DE CREATION Nº12/0366/MINESUP DU 16 AUG 2012 / AUTORISATION D'OUVERTURE Nº12/0370/MINESUP DU 16 AUG 2012

ANNEE ACADEMIQUE 2017/2018

## EXAMEN DU PREMIER SEMESTRE

Matière : ELECTRONIQUE DE BASE

Spécialité: TC1 INDUSTRIE ET TECHNOLOGIE

**Enseignant: M. MENGAPTCHE** 

DUREE: 2h00 GERCICE 1

/6,5pts

1.1. Qu'est-ce qu'un semi-conducteur dopé?

1.2. Entre les porteurs majoritaires et les porteurs minoritaires d'une diode à jonction polarisée en direct, lesquels sont susceptibles de provoquer sa destruction en cas d'agitation thermique intense? 1.3. Le courant dans une diode à jonction est-il dû à une double conduction ? si oui, expliquez. 0,25pt + 0,5pt=0,75pt

1.4. Citer quatre domaines d'application des diodes à jonction.

 $0.25pt \times 4 = 1pt$ 

1.5. Donner le modèle équivalent petit signaux de haute fréquence d'une diode

1.5.a. En direct

1.5.b. En inverse

1.6. Citer trois critères de choix d'une diode ZENR.

0.25pt x 3 = 0.75pt

1.7. Dessinez la structure physique réelle d'une diode PN

0,5pt

1.8. Donner l'expression du courant direct d'une diode en fonction de son courant de saturation. 1.9. Donner le symbole de chacune des diodes suivantes :

0,5pt

0,5pt

1.5.a. Diode Tunnel

0.25pt

0.25pt

5.c. Photodiode

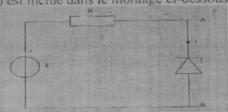
0.25pt

1.5.d. Diode unitunnel

0.25pt

XERCICE 2 / 5,5pts

ne diode ZENER ( $r_z = 10 \Omega$ ;  $V_{zo} = 7.5 V$ ) est inclue dans le montage ci-dessous Où, E = 12 V;



1. Esquissez la caractéristique courant-tension en approximation réelle d'une diode ZENER

0,5pt

2. Calculer R pour que l'intensité i circulant dans la ZENER soit égale à 5 mA.

1.2. Remplacer la diode ZENER par son modèle équivalent et exprimer, en fonction de E, R, Vz0 et rz, les 2 éléments ETh

RTh du générateur de THEVENIN équivalent vus des bornes A et B. 2.3. Exprimer, en fonction de R et rz, la quantité dETh/dE.

1pt

2.4. Comment varie E1h lorsque E augmente de de 2 V?

0,5pt

5. v-a-t-il stabilisation aval ? Justifier

0.25Pt x 2=0.5pt

On connecte aux bornes A et B du circuit précédent une résistance X.

6. Calculer en fonction de E, Vz0, R, vz et X le courant Ix circulant dans cette résistance, puis faite l'application rumerique pour  $X = 2000 \Omega$ .

EXERCICE 3/8pts

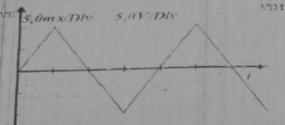
Soit le schéma de la figure ci-contre

3.1. Lors d'une alternance positive, quelles diodes sont passantes ?

TR2

3.2. Lors d'une alternance négative, quelles diodes sont passantes ?

Tracer les chronogrammes de VS, avec VE donnée comme ci-dessous. 3:3.



3.4. On remplace VE par une tension sinusoïdale de même amplitude et même fréquence que le signaprécédent ;

3.4.a. déterminer la valeur qu'affichera un voltmètre en position DC branché en parallèle avec R 13.4.b. déterminer la valeur qu'affichera un voltmètre en position AC branché en parallèle avec R

3.5. On place en parallèle avec R un condensateur C qui filtre la tension VS. 3.5.a. Est-ce que la valeur qu'affichera le voltmètre en position DC branché en parallèle avec (R//C) sera

identique? si non justifier votre réponse 3.5.b. Si la valeur moyenne après filtrage est de VS moy = 7V, Déterminer la valeur maximale VS max et la

valeur minimale VS min de VS pour une ondulation en sortie de 2V. 3.5.c. Donner la forme d'onde de VS après le filtrage

! pt

3.5.d. Calculer la valeur de C